

УДК 538.945

МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
В МОНОКРИСТАЛЛАХ СВЕРХПРОВОДНИКА
 $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$

B. Ф. Мастеров, A. B. Федоров, C. B. Козырев, K. F. Штельмах

Проведены исследования эффекта квантования захваченного магнитного потока в монокристаллических и керамических образцах $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. Показано, что полученные результаты могут быть объяснены в рамках модели «спинового стекла» (керамика) и регулярной сетки джозефсоновских контуров (монокристалл).

Как известно [1-3], в высокотемпературных сверхпроводниках в области слабых магнитных полей наблюдается зависящее от H поглощение СВЧ мощности. В настоящее время существуют два альтернативных объяснения этого эффекта: во-первых, высказанное в первых работах [1, 3] предположение о наличии в неупорядоченных ВТСП сверхпроводящих контуров с включенными джозефсоновскими переходами, что близко к идею существования в неупорядоченных сверхпроводниках состояния типа «спиновое стекло» [4]; во-вторых, движением «гипервихрей» в множественной джозефсоновской среде [5]. В настоящей работе обнаружены особенности поглощения СВЧ мощности в монокристаллических и керамических образцах $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, связанные с квантованием захваченного магнитного потока. Эти результаты, а также эффекты, наблюдавшиеся в [6, 7], объясняются нами в рамках модели «сверхпроводящих контуров».

Нами использовались монокристаллические образцы размерами $3 \times 2 \times 0.04$ мм и керамические $3 \times 2 \times 1$ мм. Измерения проводили при 77 К на спектрометре ЭПР фирмы «Radiopan», при 4 К на спектрометре фирмы «Bruker». В ВТСП-монокристаллах, ориентированных так, что плоскости двойникования практически параллельны направлению H , при малой глубине модуляции магнитного поля (0.05 Э), при развертке магнитного поля наблюдалось периодическое (по полю) изменение мощности СВЧ, отраженной от резонатора с образцом, охлажденным в пулевом магнитном поле (рис. 1, б). Аналогичные спектры наблюдались нами и на образцах, моделирующих джозефсоновскую среду, которые представляли собой диэлектрическую матрицу (клей БФ), наполненную порошком ниobia с характерным размером зерен ~ 2 мкм. Зависимость производной $\partial\chi''/\partial H$ от магнитного поля, полученная при $T < T_c$ на одном из таких образцов, приведена на рис. 1, в. Характерно, что периодическая зависимость (рис. 1, в) наблюдается при охлаждении образца в нулевом или слабом магнитном поле. При охлаждении образца в поле $H > H_c$, спектры типа рис. 1, в не наблюдались. Таким образом, сходство полученных результатов для таких разных неупорядоченных сверхпроводников, как модельная система на основе Nb и монокристалл $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, в котором безусловно имеются структурные дефекты (например, плоскости двойникования), позволяет сделать выводы: 1) периодическое по магнитному полю поглощение СВЧ мощности характерно для сверхпроводников, содержащих внутренние джозефсоновские контакты; 2) это поглощение

зависит от способа охлаждения образца ниже T_c (в магнитном поле или без него).

Для качественного объяснения экспериментальной зависимости типа рис. 1, б предположим, что в образце имеются контуры, образованные плоскостями двойникования одного размера (с площадью S) и равными энергиями связи между ними. Тогда зависимость энергии такой системы от магнитного поля будет иметь вид, представленный на рис. 1, а [4].

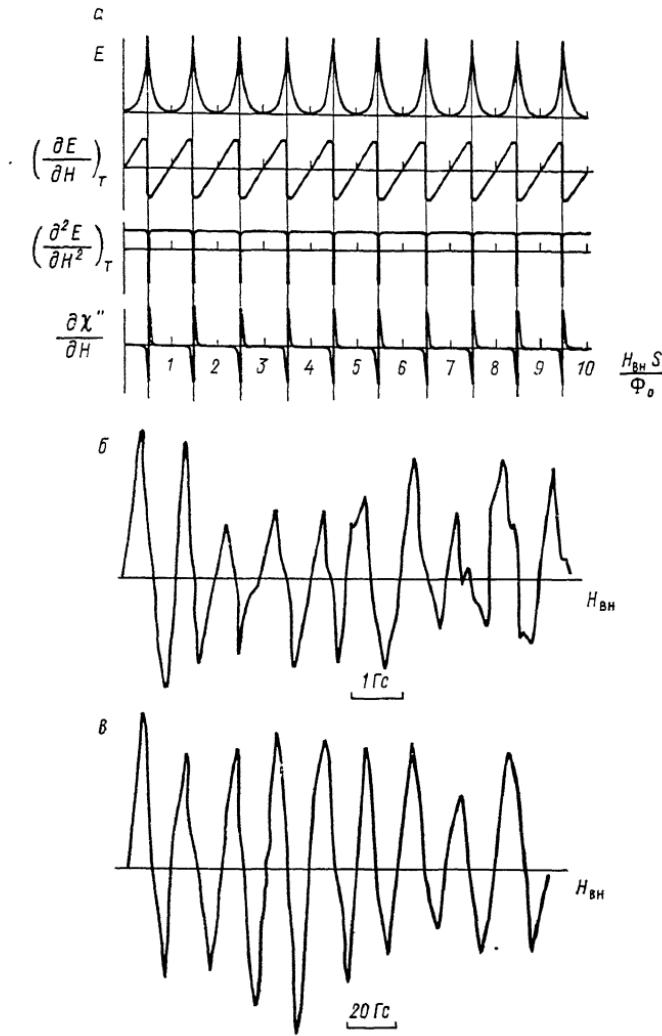


Рис. 1. Зависимость внутренней энергии упорядоченной системы сверхпроводящих контуров с включенными джозефсоновскими переходами (α); зависимости $d\chi''/dH$, которая и наблюдается в эксперименте. Из известных литературных данных наиболее узкие линии, полученные Блэзи и др. [7], имели ширину 0.002 Э при расстоянии между ними 0.25 Э, 4.4 К. В нашем случае при более высокой температуре 77 К линии уширились до 0.35 Гс, а характерное расстояние между ними ΔH составляло 0.8 Гс при $H_{\text{внеш}} \parallel \langle 110 \rangle$. Допущение о близости параметров контуров для достаточно совершенных монокристаллов $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$ не кажется нам слишком сильным из-за высокой периодичности расположения плоскостей двойникования в них.

На этом же рисунке приведены первая и вторая производные от энергии, т. е. намагниченность и магнитная восприимчивость в зависимости от поля. Самый нижний график — зависимость $d\chi''/dH$, которая и наблюдается в эксперименте. Из известных литературных данных наиболее узкие линии, полученные Блэзи и др. [7], имели ширину 0.002 Э при расстоянии между ними 0.25 Э, 4.4 К. В нашем случае при более высокой температуре 77 К линии уширились до 0.35 Гс, а характерное расстояние между ними ΔH составляло 0.8 Гс при $H_{\text{внеш}} \parallel \langle 110 \rangle$. Допущение о близости параметров контуров для достаточно совершенных монокристаллов $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$ не кажется нам слишком сильным из-за высокой периодичности расположения плоскостей двойникования в них.

При увеличении глубины модуляции магнитного поля (до 2.5 Э) мы наблюдали исчезновение структуры спектра и появление модуляционно-уширенной линии с одновременным увеличением ее интенсивности.

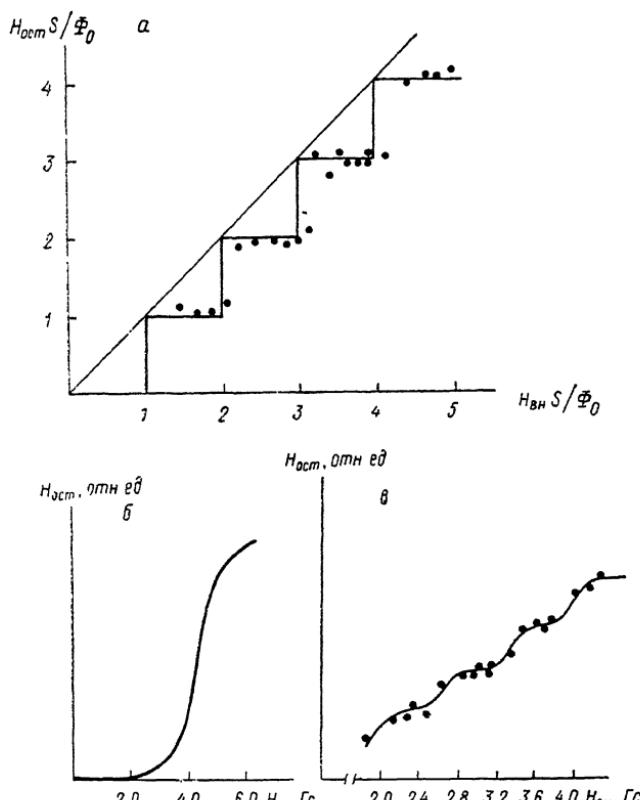


Рис. 2. Зависимости захваченного магнитного потока для монокристаллита $Y_1Ba_2Cu_1O_{7-\delta}$ от магнитного поля H_{BH} , в котором происходит охлаждение ($S=2.5 \cdot 10^{-7} \text{ см}^2$) (а); для керамических образцов $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$ от внешнего магнитного поля при охлаждении в нулевом (б) и конечном магнитном поле, $S=7.9 \cdot 10^{-7} \text{ см}^2$ (в).

Для изучения захвата магнитного потока монокристалл охлаждался в различных магнитных полях, а затем при понижении поля при $T < T_c$ определялось положение максимума линии по магнитному полю H_{osc} (нуль производной $\partial\chi''/\partial H$). Полученные при этом результаты приведены на рис. 2, а. Характерно, что захват магнитного потока начинается с $H_1 = \Phi_0/S$, где S — площадь контура, Φ_0 — квант магнитного потока, как и следует из зависимости $E(H)$ на рис. 1, а.

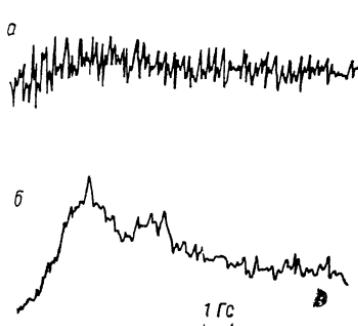


Рис. 3. Зависимость $\partial\chi''/\partial H$ для керамических образцов $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-\delta}$ при малой амплитуде модуляции магнитного поля $H_m = 0.01 \text{ Гс}$ (а) и модуляционно-уширенный спектр, $H_m = 1 \text{ Гс}$ (б).

В отличие от монокристаллических в керамических образцах при малых амплитудах модуляции магнитного поля ($H < 0.1$ Э) спектр поглощения в зависимости от магнитного поля представляет собой мезоскопический сигнал (рис. 3, а). Очевидно, форма спектра при этом определяется интерференцией вкладов от джозефсоновских контуров, имеющих разброс как по энергии связи, так и по эффективным размерам площадей (состояние

стекла [4]). При увеличении амплитуды модуляции H_m линия уширяется и уменьшается амплитуда мезоскопического сигнала (рис. 3, б).

При охлаждении образца в нулевом магнитном поле захват потока начинается с некоторого значения H_{c1}^* (рис. 2, б). Величина H_{c1}^* в зависимости от образца меняется от десятых до единиц эрстеда. При $H_{\text{внеш}} > H_{c1}^*$ квантование захваченного магнитного потока не наблюдается, как видно из рисунка.

Однако если эксперимент проводится при охлаждении в поле, то и для керамических образцов в зависимости $H_{\text{ост}}$ от $H_{\text{внеш}}$ появляются характерные ступеньки (рис. 2, в), свидетельствующие о квантовании захваченного потока. Одной из возможных причин этого явления может быть существование в керамических образцах достаточно острого распределения отдельных кристаллитов по размерам. Оценка площади петли, на которой происходит захват потока, по величине $H_{\text{ост}}$ дает значение, совпадающее с средним размером зерна в керамике (для исследуемого образца $S=7.9 \cdot 10^{-7}$ см²).

Авторы благодарны С. М. Дунаевскому за предоставление монокристаллов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ и С. Э. Хабарову за приготовление керамических образцов.

Список литературы

- [1] Мастеров В. Ф., Егоров А. И., Герасимов Н. П. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. № 7. С. 289—292.
- [2] Кведор В. В., Мchedlidze Т. Р., Осильян Ю. А., Шалыгин А. И. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. Приложение. С. 176—179.
- [3] Blazey K. M., Müller K. A., Bednorz J. G. et al. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 13. P. 7241—7243.
- [4] Ebner C., Stroud D. // Phys. Rev. B. 1985. V. 31. N 1. P. 165—171.
- [5] Сонин Э. Б. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47. № 8. С. 415—418.
- [6] Богачев С. В., Емельченко Г. А., Ильин В. А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 47. № 3. С. 166—169.
- [7] Blazey K. M., Portic A. M., Müller K. A. et al. // Physica. 1988. V. 153—155. Pt. 1. P. 56—58.

Ленинградский политехнический
институт им. М. И. Калинина
Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступила в редакцию
30 мая 1989 г.